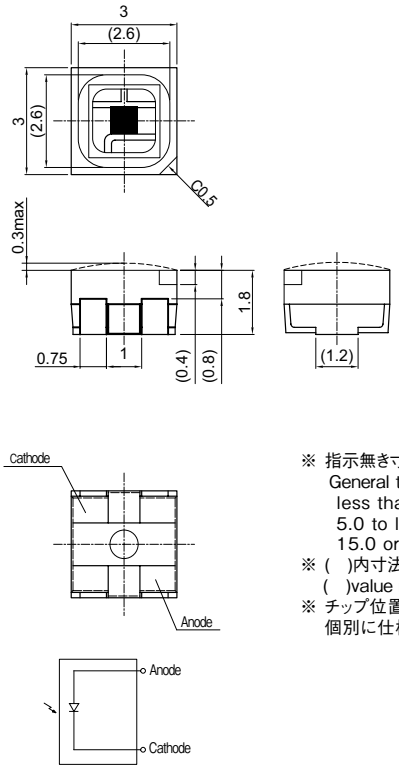
KD1366

シリコンフォトダイオード

Silicon Photo Diode

Pb Free | Photo diode

Dimension(Unit:mm)



※ 指示無き寸法は下記の通りとする
General tolerance unless otherwise noted

less than 5.0	±0.2
5.0 to less than 15.0	±0.3
15.0 or over	±0.5

※ ( )内寸法は参考値とする
( )value means for reference only
※ チップ位置は、チップタイプによって異なります
個別に仕様書にてご確認ください

■概要 Description

KD1366 は、プレーナータイプのシリコン・フォトダイオードチップを表面実装型パッケージに組み込んだフォトダイオードです。

Model **KD1366** is silicon photodiode mounted in Surface mount package.

■特長 Feature

- 高感度フォトダイオード（λp:900nm）
- Photo diode（λp:900nm）

■用途 Application

- 紙幣のパターン読み取り用受光素子
- 紙幣パターン識別用受光素子
- Photo detector for Bill validator
- Photo detector for printing discrimination

■最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

Item	Symbol	Rating	Unit
逆電圧 Reverse Voltage	V_R	30	V
許容損失 Power Dissipation	P_D	100	mW
動作温度 Operating Temperature	Topr	-20 ～ +85	℃
保存温度 Storage Temperature	Tstg	-30 ～ +95	℃
半田付温度 Soldering Temperature ※1	Tsol	260	℃

※ 1. 無鉛リフロー半田
※ 2. EV：CIE 標準 A 光源

※ 1. Reflow process required
※ 2. EV：CIE STD. A Light source

■電気的光学的特性 Electro-Optical Characteristics [Ta=25℃ **]

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
暗電流 Dark Current	I_D	V_R=10V, E_V=0 lx ※2	–	–	10	nA
短絡電流 Short Circuit Current	I_{SC}	E_V=1000 lx ※2	0.5	–	–	μA
ピーク感度波長 Peak Wavelength	λp	–	–	900	–	nm
指向角半値幅 Half Angle	Δθ	–	–	± 60	–	deg
応答時間 Response Time 上昇 Rise Time	tr	V_R=5V,R_L=1kΩ	–	3	–	μs
応答時間 Response Time 下降 Fall Time	tf	V_R=5V,R_L=1kΩ	–	3	–	μs

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

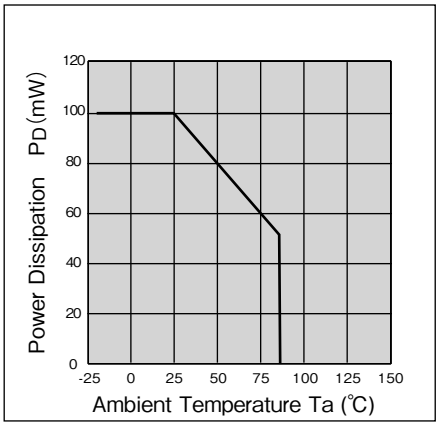
KD1366

定格・特性曲線
Characteristics

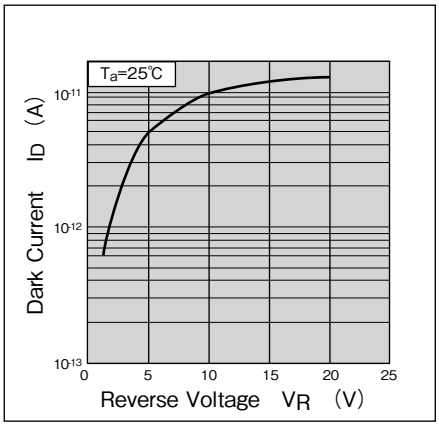
※注意　最大定格を超えないようにご使用ください

Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

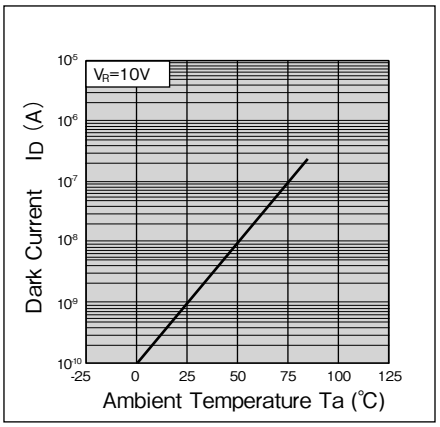
許容損失低減曲線



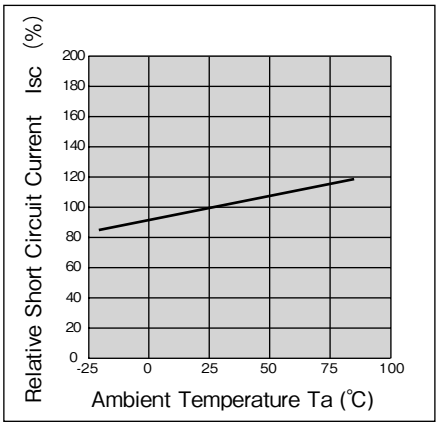
暗電流ー逆電圧特性(代表例)



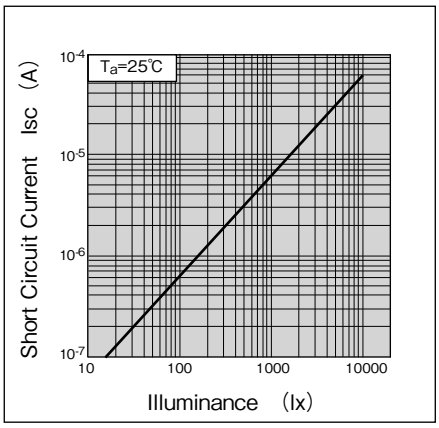
暗電流ー周囲温度特性(代表例)



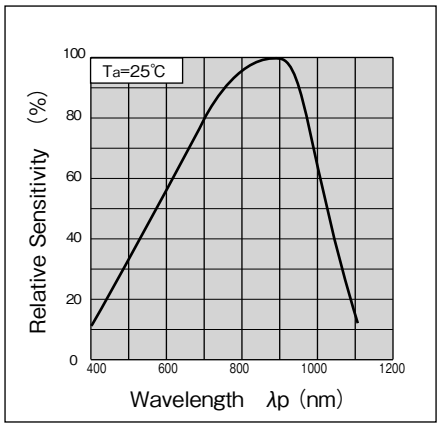
短絡電流ー周囲温度特性(代表例)



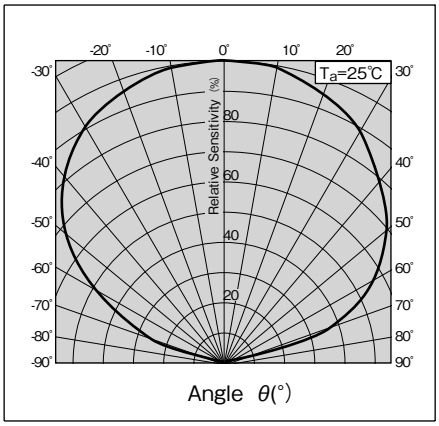
短絡電流ー照度特性(代表例)



分光感度特性(代表例)



指向特性(代表例)



・カスタムも承ります。お気軽にお問合せください。　・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

・A Custom designed package is available on request.・Specification are subject to change without notice.

TASHIKA CO., LTD.

1-12, Kaiyo-cho, Ashiya, 659-0035, JAPAN

Tel: + 81-797-23-9035　Fax: + 81-797-23-2105

e-mail: sales@tashika.co.jp　URL:　www.tashika.co.jp